

特許等(デバイス工学分野)

Hideo Takeuchi and Yoshitsugu Yamamoto: Method and apparatus for measuring surface carrier recombination velocity and surface Fermi level, United States Patent 7420684, September 2, 2008.

Hideo Takeuchi and Yoshitsugu Yamamoto: Method and apparatus for evaluating semiconductor layers, United States Patent 7656514, February 2, 2010.

竹内 日出雄, 山本 佳嗣: 表面キャリア再結合速度の測定方法及び測定装置, 特許第 4441381 号, 発行日: 2010 年 1 月 15 日.

竹内 日出雄, 山本 佳嗣: 半導体多層膜の分光計測方法および分光計測装置, 特許第 4031712 号, 2008 年 1 月 9 日.

竹内 日出雄, 山本 佳嗣: 半導体装置, 特許出願 2008-52409, 2008 年 3 月 3 日.

Hideo Takeuchi and Yoshitsugu Yamamoto: Semiconductor Device, United States Application No. 12/143053, June 20, 2008.